

奈米中心氧化擴散系統 B 及 Sintering 爐管實作考核記錄表

110.01.27 製表

學校系所：_____ 姓名：_____

學號：_____ 考核日期：_____

一. 筆試: 填空題 30% (每空格 2 分)

1. 機台升溫速率勿超過 $^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ，機台最高操作設定溫度 $^{\circ}\text{C}$ ，爐管溫度需高於 $^{\circ}\text{C}$ 才能通入 H_2 。
2. 爐管目前僅開放何種晶片 _____，其餘材質晶片均未開放。
3. N_2 預設流量 LPM ，另操作設定時 O_2 流量為 LPM ， H_2 流量為 _____ LPM 。
4. 氧化擴散爐管預設爐溫為 $^{\circ}\text{C}$ ，Sintering 爐管預設爐溫為 _____ $^{\circ}\text{C}$ 。
5. 使用爐管前乾氧製程晶片須經 _____ 清洗，溼氧製程或 Sintering 製程時晶片須經 _____ 或 _____ 清洗。
6. 晶舟材質為何 _____，取用晶舟原則為 _____。
7. 放置擾流板或晶舟第一片載片作用為何 _____。

二. 實作: 70%

- __ 1. 操作前檢查作業: 確認電、氣供應，紀錄簿注意事項，使用紀錄填寫及操作標示牌等事項。(10%)
- __ 2. 晶片準備，晶舟進爐管前於進料桿之放置點。(10%)
- __ 3. 各項操作步驟
 - 乾氧，溼氧及 Sintering 製程選定(5%)
 - 控制面盤功能操作(10%)
 - 製程參數設定及解說(10%)
 - 昇溫曲線及操作資料查詢(10%)
 - 爐膛開啟條件(5%)
 - 實驗結束後復歸作為(5%)
- __ 4. 異常警報及狀況處置(5%)

P.S: (1) 考核及格分數為 80 分

(2) 通過考核者請至機台管理者處登錄開卡後方得操作。

分數: _____ 考核員簽名: _____